



GaAs

主要性能参数						
单晶	掺杂	导电类型	载流子浓度 cm ⁻³	位错密度 cm ⁻²	生长方法 最大尺寸	标准基片
<100>	None	SI	/	<5×10 ³	LEC	Dia4" ×0.625
	Si	N	>5×10 ¹⁷		HB	Dia3" ×0.35
	Zn	P	>5×10 ¹⁷		Dia3"	Dia2" ×0.35
尺寸 (mm)		25×25×0.35mm、10×10×0.35mm 可按照客户需求，定制特殊方向和尺寸的衬底				
表面粗糙度		Surface roughness(Ra): ≤5A 可提供原子粒显微镜 (AFM) 检测报告				
抛光		单面或双面				
包装		100 级洁净袋，1000 级超净室				